

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5457DC-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 6A CHIPFET</p>
	<p>Datenblätter:  SI5457DC-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 2618 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI5457DC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6A CHIPFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2618 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	36 mOhm @ 4.9A, 4.5V
Verlustleistung (max)	5.7W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5457DC-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6A (Tc) 5.7W (Tc) Surface Mount 1206-8
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SI5457DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5457DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5457DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5457DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5457DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 6A CHIPFET</p>	 <p>SI5458DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5458DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5461DC-T1 VISHAY SI5461DC-T1 VISHAY</p>
 <p>SI5449DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 3.1A 1206-8</p>	 <p>SI5456DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5456DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5457DC-T1-E3 VISHAY SI5457DC-T1-E3 VISHAY</p>

SI5457DC-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5457DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5457DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5457DC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5457DC-T1-GE3
SI5457DC-T1-GE3 Electronic	SI5457DC-T1-GE3 Komponenten	SI5457DC-T1-GE3 Hersteller	SI5457DC-T1-GE3 Verteiler	SI5457DC-T1-GE3 Bild	SI5457DC-T1-GE3 Teil
SI5457DC-T1-GE3 Preis	SI5457DC-T1-GE3 Original	SI5457DC-T1-GE3 Bild	SI5457DC-T1-GE3 garantiert	SI5457DC-T1-GE3 RFQ	SI5457DC-T1-GE3 Inventar
SI5457DC-T1-GE3 Neu					SI5457DC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited